

### Сведения о ведущей организации

по диссертации Курчикова Константина Алексеевича

«Модификация пористых материалов с низкой диэлектрической проницаемостью под действием ультрафиолетового излучения. Контроль уровня ультрафиолетового излучения плазмы»

по специальности 01.04.08 – "Физика плазмы". на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технологический институт Российской академии наук
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	ФТИАН РАН
Почтовый индекс, адрес организации	117218, Москва, Нахимовский проспект, 34
Веб-сайт	<a href="http://ftian.ru/">http://ftian.ru/</a>
Телефон	Тел.: (499) 129-50-04 Факс: (499) 125-38-26
Сведения о руководителе, на имя которого нужно оформить письмо	ВРИО директора ФТИАН, д. ф.-м. н., член-корр. РАН Лукичев В.Ф.
Сведения о лице, с которым была достигнута предварительная договоренность по отзыву	С.н.с., к.ф.м.н. Мяконьких Андрей Валерьевич
Адрес электронной почты	miakonkikh@ftian.ru, amiakonkikh@gmail.com
Наименование структурного подразделения, составляющего отзыв	Лаборатория микроструктурирования и субмикронных приборов
Список основных публикаций работников структурного подразделения, составляющего отзыв, за последние пять лет по теме диссертации:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. V. Vyurkov, I. Semenikhin, S. Filippov, and A. Orlikovsky. Quantum simulation of an ultrathin body field-effect transistor with channel imperfections. Solid-State Electronics, V. 70, pp. 106–113 (2012).</li> <li>2. Фотовольтаический эффект в структуре на основе аморфного и нанопористого кремния, сформированной методом плазменно-иммерсионной ионной имплантации / А.В. Мяконьких, А.Е. Рогожин, К.В. Руденко, В.Ф. Лукичев // Микроэлектроника. 2013. Т. 42. № 4. С. 306.</li> <li>3. Miakonkikh A., Lisovsky S., Rudenko M., Rudenko K. // Instrumented wafer as a Langmuir multiprobe tool for lateral plasma homogeneity measurements in processing plasma reactors/ В сборнике: Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering Сер. "International Conference Micro- and Nano-Electronics 2012" 2012. С. 870004</li> <li>4. Svintsov D., Vyurkov V., Orlikovsky A., Ryzhii V., Otsuji T. //All-graphene field-effect transistor based on lateral tunnelling / Journal of Physics D: Applied Physics. 2014. Т. 47. № 9. С. 094002. DOI: 10.1088/0022-3727/47/9/094002.</li> <li>5. Фадеев А.В., Руденко К.В. // Исследование латерального распределения частиц <math>BF_3</math> плазмы с помощью двухракурсной эмиссионной томографии / Микроэлектроника. 2014. Т. 43. № 6. С. 435.</li> </ol>	

ВРИО директора ФТИАН РАН  
Член-корр. РАН



В.Ф. Лукичев